

富士IGBTモジュール『Nシリーズ』 2MBI100NC-120

低損失・高速スイッチング形『Nシリーズ』

1200V/100A/ 2 個組

■特長：Features

- 高速スイッチング High Speed Switching
- 電圧駆動 Voltage Drive
- 低インダクタンスモジュール構造
Low Inductance Module Structure

■用途：Applications

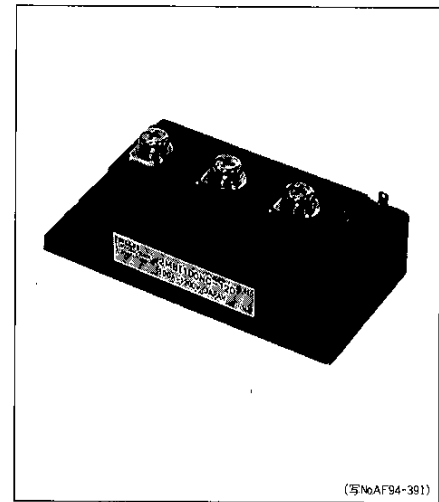
- モータ駆動用インバータ Inverter for Motor Drive
- AC, DCサーボアンプ AC and DC Servo Drive Amplifier
- 無停電電源 Uninterruptible Power Supply
- 溶接機等の産業用機器
Industrial Machines, such as Welding Machines

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C)

Items	Symbols	Ratings	Units
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEs}	1200	V
ゲート・エミッタ間電圧	V _{GES}	±20	V
コレクタ電流	連続	I _c	100
	1ms	I _c pulse	200
	連続	-I _c	100
	1ms	-I _c pulse	200
最大損失	PC	780	W
接合部温度	T _j	+150	°C
保存温度	T _{stg}	-40~+125	°C
絶縁耐量	AC 1min	Vis	AC 2500 (1min.)
締付けトルク	Mounting *1	3.5	N・m
	Terminals *1	3.5	

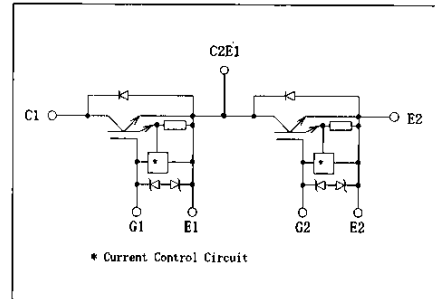
*1 推奨値：Recommendable value：2.5~3.5 N・m (M5)



(写NoAF94-391)

■等価回路：

Equivalent Circuit Schematic



* Current Control Circuit

●電気的特性：Electrical Characteristics (T_j=25°C)

Items	Symbols	Characteristics			Conditions	Units
		min.	typ.	max.		
コレクタ・エミッタ間遮断電流	I _{CEs}			2.0	V _{GE} =0V, V _{CE} =1200V	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	I _{GES}			30	V _{CE} =0V, V _{GE} =±20V	μA
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	V _{GE} (th)	4.5		7.5	V _{CE} =20V, I _c =100mA	V
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V _{CE} (sat)			3.3	V _{GE} =15V, I _c =100A	V
入力容量	C _{ies}		16000		V _{GE} =0V	pF
出力容量	C _{oes}		5800		V _{CE} =10V	
帰還容量	C _{res}		5160		f=1MHz	
ターンオン時間	ton		0.65	1.2	V _{CC} =600V I _c =100A	μs
	tr		0.25	0.6		
ターンオフ時間	toff		0.85	1.5	V _{GE} =±15V R _G =9.1Ω	μs
	tf		0.35	0.5		
ダイオード順電圧	V _F			3.0	I _F =100A, V _{GE} =0V	V
逆回復時間	t _{rr}			350	I _F =100A	ns

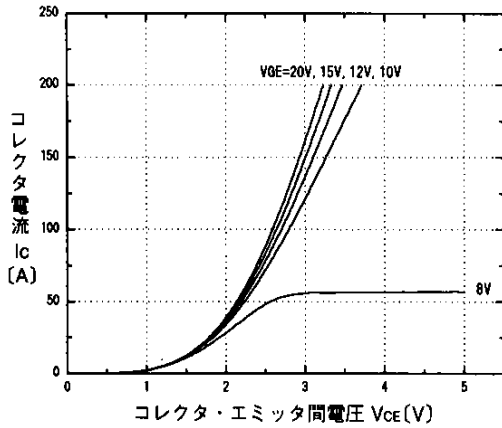
●熱的特性：Thermal Characteristics

Items	Symbols	Characteristics			Conditions	Units
		min.	typ.	max.		
熱抵抗	R _{th} (j-c)			0.16	IGBT	°C/W
	R _{th} (j-c)			0.33	Diode	
	R _{th} (c-f) ※		0.025		the base to cooling fin	

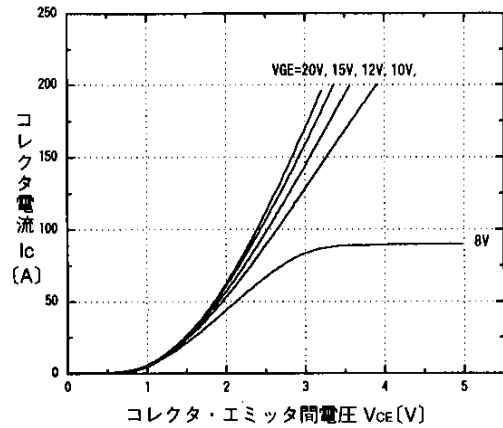
※サーマルコンパウンドを使用して放熱フィン上にモジュールを取り付けた時の接触熱抵抗値

※ This is the value which is defined mounting on the additional cooling fin with thermal compound.

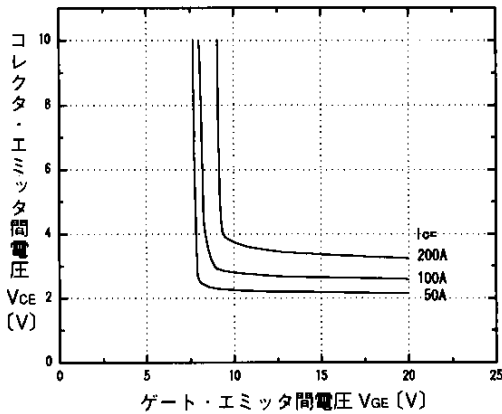
■特性曲線 : Characteristics



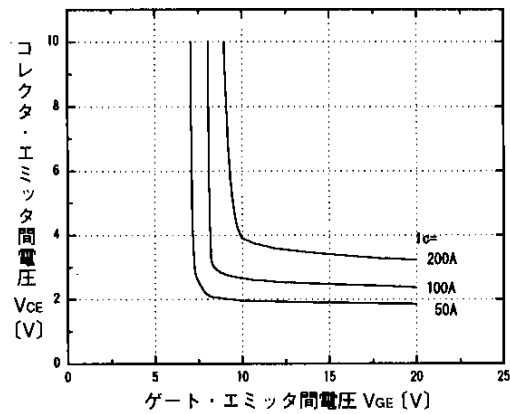
コレクタ電流-コレクタ・エミッタ間電圧特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$)
Collector current vs. Collector-Emitter voltage



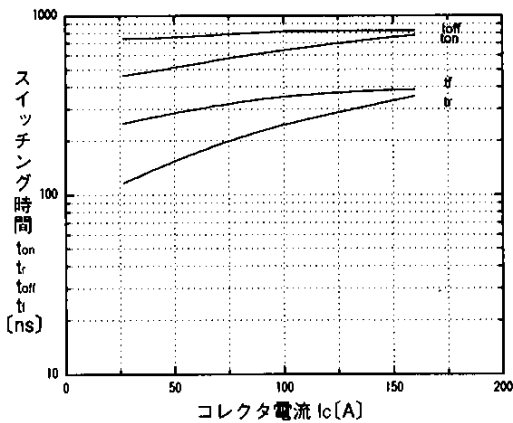
コレクタ電流-コレクタ・エミッタ間電圧特性 ($T_j=125^\circ\text{C}$)
Collector current vs. Collector-Emitter voltage



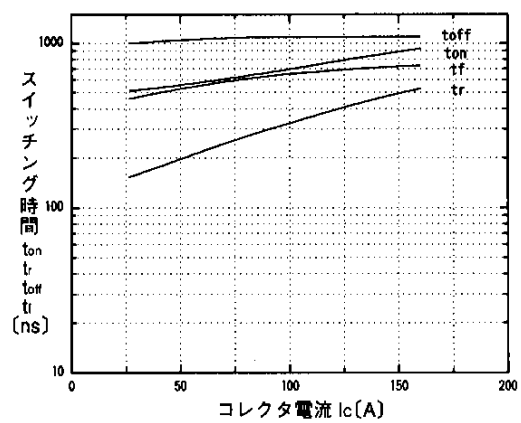
コレクタ・エミッタ間電圧-ゲート・エミッタ間電圧特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$)
Collector-Emitter voltage vs. Gate-Emitter voltage



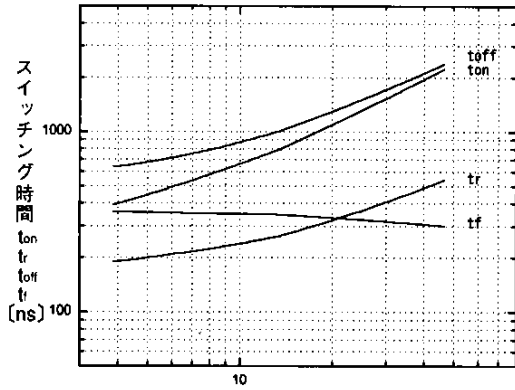
コレクタ・エミッタ間電圧-ゲート・エミッタ間電圧特性 ($T_j=125^\circ\text{C}$)
Collector-Emitter voltage vs. Gate-Emitter voltage



スイッチング時間-コレクタ電流特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$)
Switching time vs. Collector current

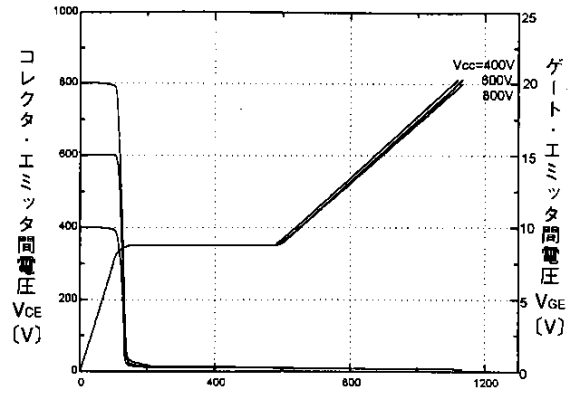


スイッチング時間-コレクタ電流特性 ($T_j=125^\circ\text{C}$)
Switching time vs. Collector current



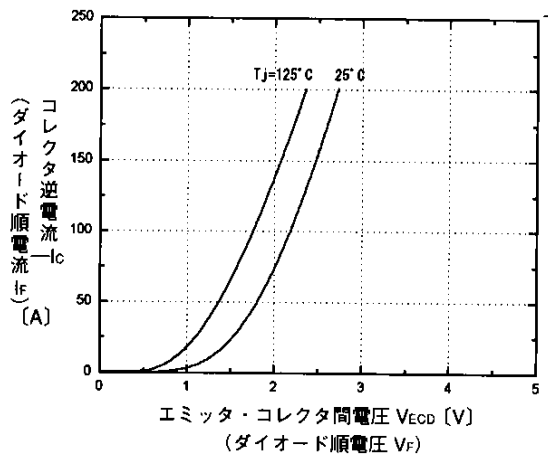
ゲート抵抗 R_g (Ω)

スイッチング時間-ゲート抵抗特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$)
Switching time vs. Gate resistance



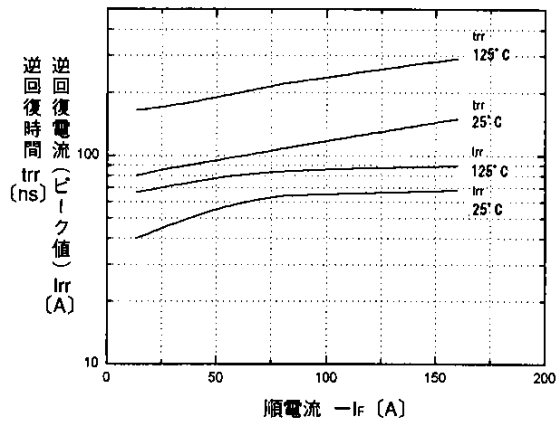
充電電荷量 Q_g (nC)

ダイナミック入力特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$)
Dynamic input characteristic



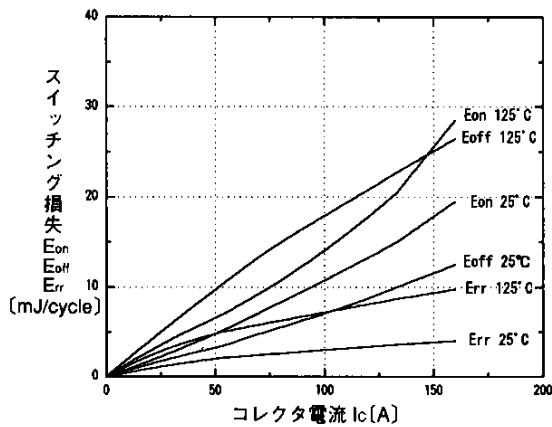
エミッタ・コレクタ間電圧 V_{ceD} (V)
(ダイオード順電圧 V_F)

高速フリーホイールダイオード順電圧特性
Forward voltage of free wheel diode



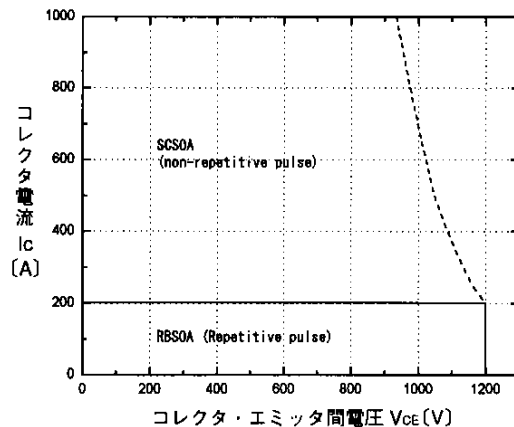
順電流 I_F (A)

T_{rr} , I_{rr-I_F} 特性
 T_{rr} , I_{rr-I_F}



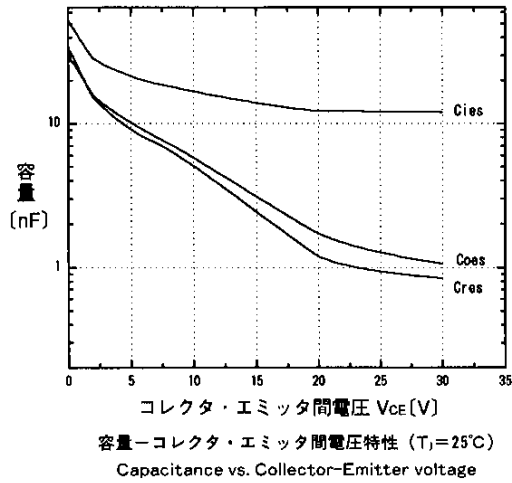
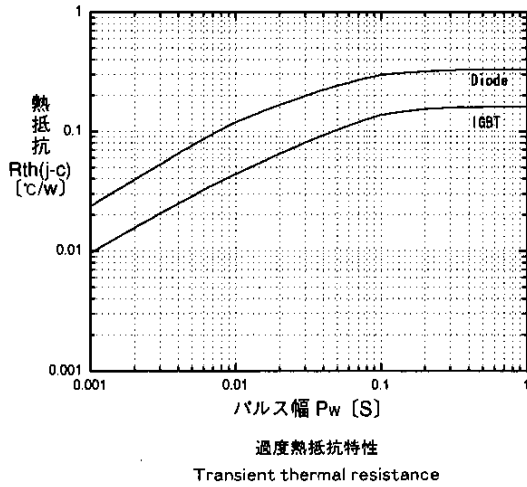
コレクタ電流 I_c (A)

スイッチング損失-コレクタ電流特性
Switching loss vs. Collector current

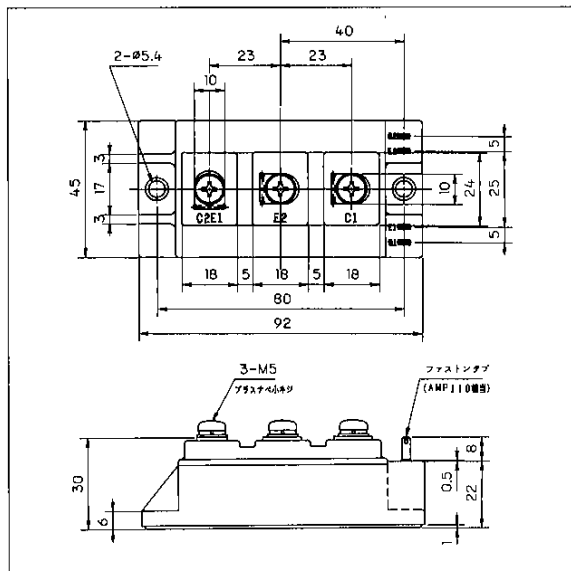


コレクタ・エミッタ間電圧 V_{CE} (V)

安全動作領域 (逆バイアス) ($T_j \leq 125^\circ\text{C}$)
Reverse biased safe operating area



■外形寸法：Outline Drawings



輸出に際してのお願い：本品のうちで、戦略物資（または役務）に該当するものを輸出される場合は、外国為替及び外国貿易管理法に基づく輸出許可が必要です。

富士電機株式会社

電子事業本部・半導体事業部

☎ (03) 5388-7622

(03) 5388-7651

〒100 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号
(新宿コヤマビル)

営業統括部 (03) 5388-7657
(03) 5388-7680
長野電子営業課 (0263) 36-6740
海外営業部 (03) 5388-7685

●支社
北海道 (011) 271-3377
東北 (022) 222-1110
北陸 (0764) 41-1231
中部 (052) 204-0295
関西 (06) 455-6467
中国 (082) 237-6992
四国 (0878) 23-3110

九州 (092) 731-7111

●営業所
浜松 (053) 485-0380